

## 詞彙表

本詞彙表載有本文件所用有關我們的業務及半導體行業的若干詞彙說明。下文所載詞彙及其涵義未必符合標準行業涵義或用法。

「十二五規劃」	指	中國共產黨第十七屆中央委員會第五次全體會議頒佈的中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要
「模擬」	指	一組用於處理時間和幅度都為連續可變信號的電路
「ASIC」	指	特定應用集成電路，按照客戶指定的功能要求設計及製造的專用集成電路
「BCD」	指	Bipolar-CMOS-DMOS為一項重要的電源IC工藝技術。BCD為一系列硅工藝，每一種均將三種不同製程的優勢整合到單個芯片上：Bipolar的精密模擬功能、CMOS的數字設計及DMOS（雙擴散金屬氧化物半導體）的電源及高壓元件
「BiCMOS」	指	雙極型互補金屬氧化物半導體
「雙極」	指	雙極型晶體管在單晶體管中的兩類半導體（負通道（電子）與正通道（空穴））的接觸面用於模擬功能，可作為放大器或開關或用於振盪器
「藍牙」	指	藍牙為短距離數據交換的無線技術標準
「BSI」	指	英國標準協會，一家跨國商業服務供應商，其主要業務為制定標準及提供標準相關服務
「CIS」	指	CMOS圖像傳感器
「CMOS」	指	互補式金屬氧化物半導體，一種在同一電路設計上結合n-channel及p-channel的集成電路

---

## 詞彙表

---

「CVD」	指	化學氣相沉積，指氣態化學物在加熱晶圓表面產生反應而形成固態薄膜
「DRAM」	指	動態隨機存取存儲器。這是一款隨機存取存儲器，需要恆電流透過刷新保持其所存數據。由於這一需要，該存儲器為動態存儲器，與其相對應的是在斷電時不會丟失信息的靜態存儲器
「eEEPROM」	指	嵌入式EEPROM
「EEPROM」	指	電可擦可編程只讀存儲器。可利用電將用戶選定資料擦除和在電路中編程的非易失性存儲器
「eFlash」	指	嵌入式閃存是一種嵌入式非易失性存儲器。亦請參閱「閃存」
「EMS」	指	電子製造服務指是為原始設備製造商(OEM)的電子元件及組件提供設計、測試、製造、分銷及退貨／維修服務的公司
「嵌入式非易失性存儲器」	指	嵌入式非易失性存儲器。非易失性存儲器是一種即使在斷電的情況下也能保存數據的存儲器
「ESF2」	指	ESF2為第二代SuperFlash技術，採用自我對準單元。可在嵌入式功能(尤其是汽車應用)中採用
「晶圓廠」	指	晶圓廠
「無廠半導體公司」	指	並不經營晶圓製造廠的半導體公司，僅專注於半導體產品的設計、開發及營銷。設計的生產以外包形式進行
「閃存」	指	閃存存儲器，一種可擦除大陣列位元數據的非易失性存儲器。「閃存」是形容快速擦除數據塊資料。技術上而言，閃存亦屬於EEPROM，但「閃存」一詞專門用於有能力進行許多讀／擦除／寫周期的較快存儲器

## 詞彙表

「半導體代工公司或企業」	指	半導體代工公司指製造其他公司設計的包含晶圓的半導體產品的半導體公司，有關產品用於不屬於代工半導體公司的終端市場產品。純晶圓代工廠並不供應自身的終端市場產品，因此不與其客戶競爭，而提供代工服務的集成器件製造商擁有自身的產品，有關產品可能會或不會與其代工廠客戶的產品競爭
「HBT」	指	異質結雙極性晶體管
「集成器件製造商」	指	集成器件製造商，設計、製造及銷售自身的半導體產品，因此為「集成」。集成器件製造商有自身的晶圓製造設施
「IGBT」	指	絕緣柵雙極型晶體管。主要用作電子開關的電力半導體元件
「圖像傳感器」	指	可將光學圖像轉換為電子信號的裝置。大多用於數碼相機、相機模組其他圖像裝置
「Incoterms」	指	國際貿易術語
「集成電路」	指	將所有電路元件集成於單一半導體芯片的電子電路
「ISO」	指	國際標準化組織
「ISO 14001」	指	環境管理體系的ISO認證
「ISO 14064」	指	溫室氣體排放標準
「ISO 9001」	指	ISO頒佈的關於設計、開發、生產、安裝及服務方面的質量管理體系標準
「ISO/TS 16949」	指	旨在開發出可實現持續改進、強調缺陷預防並減少變化的品質管理體系的ISO技術規範。該規範以ISO 9001為基礎
「LDMOS」	指	橫向擴散金屬氧化物半導體

## 詞彙表

「LED」	指	發光二極管(LED)是一種可以發光的兩端半導體。與白熾光源相比，LED擁有許多優勢，包括能耗低、壽命長、堅固耐用、體積小及啓動無延時
「邏輯」	指	一組稱為閘極(通常簡稱MOSFET)的電路元件，能執行所有布爾(Boolean)邏輯運算法及數學，以至高度複雜的運算，並包括多路複用器、寄存器、ALU及高端微處理器，可包含超過1億個閘極
「微控制器」	指	微控制器為單一集成電路的小型電腦，具有處理核心、存儲器及可編程輸入／輸出周邊附件。
「存儲器」	指	可儲存資料以供其後讀取的裝置
「MEMS」	指	微機電系統，一種將電腦與微型機械裝置結合的技術
「混合信號」	指	在同一裸晶同時包含數碼及模擬電路的集成電路
「mm」	指	毫米(10 <sup>-3</sup> 米)
「MOS」	指	金屬氧化物半導體
「MOSFET」	指	金屬氧化半導體場效應晶體管，用於放大或轉換電子信號
「多項目晶圓」	指	一個含有多個不同芯片主要用於驗證加工技術及／或芯片設計的晶圓
「N型摻雜」或「N型」	指	植入負極性電荷的半導體材料
「NFC」	指	近場通訊。近場通訊(NFC)是智能手機及類似設備藉相互接觸或近距離(通常不超過幾英寸)感應建立無線通訊的一套標準
「nm」	指	納米(10 <sup>-9</sup> 米)
「NOR Flash」	指	一種非易失性閃存種類

## 詞彙表

「NPT IGBT」	指	非穿通型絕緣柵雙極型晶體管是一種主要用作電子開關的電源半導體器件，兼具MOSFET與雙極型晶體管二者的特點。
「ODM」	指	原始設計製造商。原始設計製造商(ODM)是設計及製造由另一公司指定及最終貼牌進行銷售的產品的公司
「P型摻雜」或「P型」	指	植入正極性電荷的半導體材料
「PDBI」	指	財產損失和業務中斷
「PM」	指	電源管理
「PMIC」	指	電源管理集成電路
「PN」	指	一種半導體結構，通常由一層P型摻雜的半導體和一層N型摻雜的半導體組成
「PNP」	指	一種半導體結構，通常由一層N型摻雜的半導體夾雜在兩層P型摻雜的半導體中間構成
「功率器件」	指	包括MOSFET、絕緣柵雙極晶體管(IGBT)、雙極性結型晶體管(BJT)、半導體開流管及整流器／二極管
「純晶圓代工廠」	指	不提供自有終端產品因此不與其客戶競爭的半導體代工公司
「QC 080000 IECQ HSPM」	指	IECQ HSPM有害物質過程管理要求，用於評估設備製造商及有關組織機構合規過程的認證體系
「RF」	指	射頻
「RFCMOS」	指	射頻CMOS
「硅IP」	指	作為較大集成電路子元件從第三方購買或獲其特許的核心或設計

## 詞彙表

「智能電網」	指	智能電網為採用模擬或數字信息及通信技術自動採集信息(如有關供應商及客戶行為的資料)並作出反應的現代化電網，以提高發電及配電效率、穩定性、經濟性及可持續性
「SJNFET」	指	超級結MOSFET。「超級結」技術令電源開關速度更快
「SOI」	指	絕緣體上硅指具有硅－絕緣體－硅基板的晶圓，有別於傳統僅有硅的基板
「SONOS」	指	Silicon-Oxide-Nitride-Oxide-Silicon，一種非易失性存儲器技術
「SuperFlash」	指	由SST開發的專有NOR Flash存儲器技術，在多種閃存元器件及大容量閃存產品中使用。該技術採用分離閘單元結構，厚氧化物處理需要的掩膜步驟較少，從而提供較低成本的非易失性存儲器解決方案，具備良好的數據保存性能及更佳的可靠性
「技術節點」	指	一代半導體工藝，通常指半導體工藝的特徵尺寸，過往指場效應晶體管源極與漏極之間的硅溝道長度。節點愈小，可在若干面積執行的電路元件愈多。
「晶圓」	指	薄片半導體材料，如硅晶體，在其上於製造過程中多排集成電路或獨立器件加工
「Wi-Fi」	指	Wi-Fi是一種可使電子設備無線交換數據或連接互聯網的技術
「ZigBee」	指	ZigBee是一套高水平通訊協議(用於創設建立自小型、低功耗數字無線電的個人區域網絡)的規格
「 $\mu\text{m}$ 」	指	微米( $10^{-6}$ 米)